太阳光能量由直徑30吋的抛物面反射鏡加以会聚。到目前为止,利用地面的日光,这种装置已能在室溫下激起25毫瓦的連續光激射作用。在高空的时候,由于沒有大气的影响,产生功率大于1瓦的連續激射光作用,所需的反射鏡的面积不过为上述面积的一半。

摘自 Electronics, Vol. 37, № 25, (Sept., 1964) p. 33 (顏紹知报导)

## Ⅲ-Ⅴ族半导体光激射器

发展得最完整的 Ⅲ-V 族半导体光激射器为 GaAs p-n 結二极管, 其运轉波长, 于室温 时为 9000 埃, 77°K 时为 8400 埃, 于 4.2°K 时能連續运轉。

目前已获得受激振蕩的 II-V 族半导体光激射器,除 GaAs 外,倘有: InAs (77°K, 3.1 微米), In(77°K, 9000 埃), GaPAs (77°K, 7100埃), GaIn As (1.9°K, 2,07和1.77微米), In Sb (1.7°K, 5.2 微米)等二极管光激射器,Ga(PxAs<sub>1-x</sub>)已制成合金,获得光激射振蕩。此外 In As p-n 結二极管于 4.2°K 时,也能連續运轉。

摘自 Electronics Vol. 36, № 50 (1963) p. 36 (沃新能报导)

## 万能光激射器装置

最近由 M. E. L. 公开的一种万能中等功率固态光激 射器,目前已作为一种标準产品提供应用,它包括有充电和控制装置。光激射器头在椭园形反射腔中,腔中沿着一个焦点装有 閃光灯,沿着另一个焦点装有光激射器棒。光激射器头可加以修改使得适应于各种不同型式的閃光灯,和支承平的、或錐形端面的光激射器棒。适当的修改后也可应用于对不同直徑或不同材料的棒。光激射头的二端都能作为光的出口,可以很方便的装上透鏡和滤片。

正常情况下,采用的棒是钕玻璃的, 其直徑为½时长为6时, 泵源是一个5000 焦耳的 線态閃光管。相干光的正常輸出为5焦耳, 脈冲长度为0.4—0.8毫秒。 用Q 开关装置后可减少到0.1—10 微秒, 而峯值功率却增加近100倍。

标准的光激射器棒端面間平行的, 塗有电介质的, 正常的反射率一端为58%, 另一端为97%。供給的棒也可以是一端是全部內反射, 而另一端不鍍膜, 或者是不鍍膜的平行端面, 而采用外部反射器。

在 5000 焦耳处,閃光管的預期寿命超过 7000 次閃光,在稳定充电装置中用油浸金属纸电容器比电解电容器好。

制造者說:光激射器首先是用作研究和实驗工作。在实驗室外面,这种中等功率装置的可能应用包括:光学測矩,大气层調查,卫星跟踪和控制,以及导航系統。在实驗室內,則